進捗報告

バッファ回路の確認 2023/07/04 小島 光

K_0 の誤り

ドレイン電流は二乗則より

$$I = \frac{\mu C_{ox}}{2} \cdot \frac{W_1}{L_1} \cdot \left(v_{gs} - V_{th}\right)^2$$

また、 g_m はドレイン電流を v_{gs} で偏微分したものであるので

$$g_m = \mu C_{ox} \cdot \frac{W_1}{L_1} \cdot \left(v_{gs} - V_{th} \right)$$

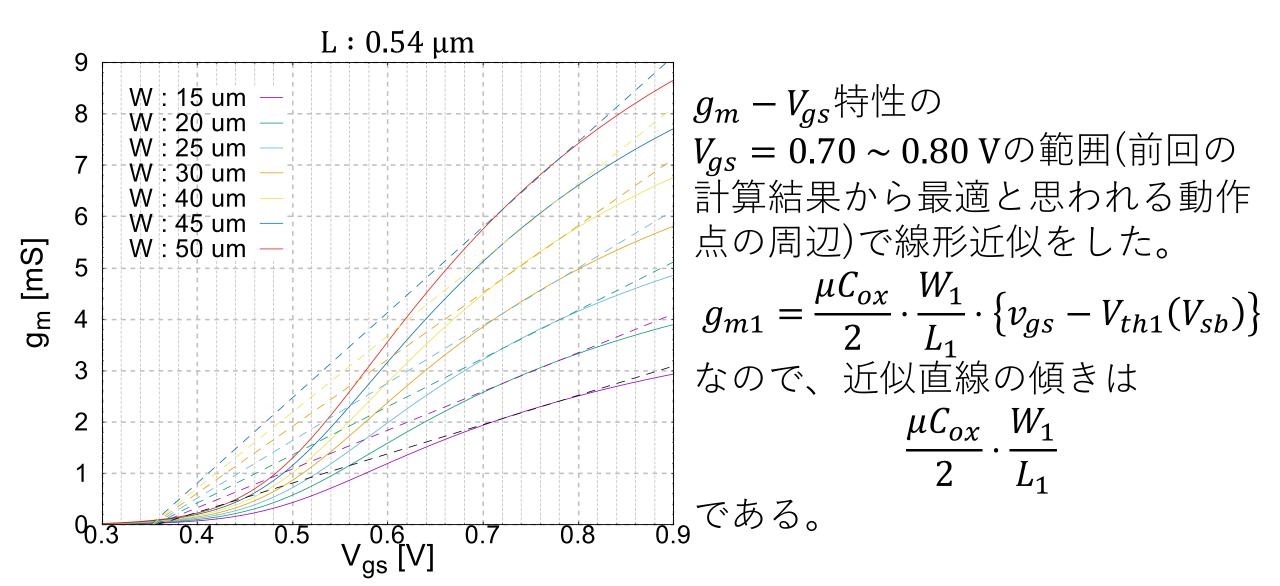
であるが、以前は間違えて

$$g_m = \frac{\mu C_{ox}}{2} \cdot \frac{W_1}{L_1} \cdot \left(v_{gs} - V_{th} \right)$$

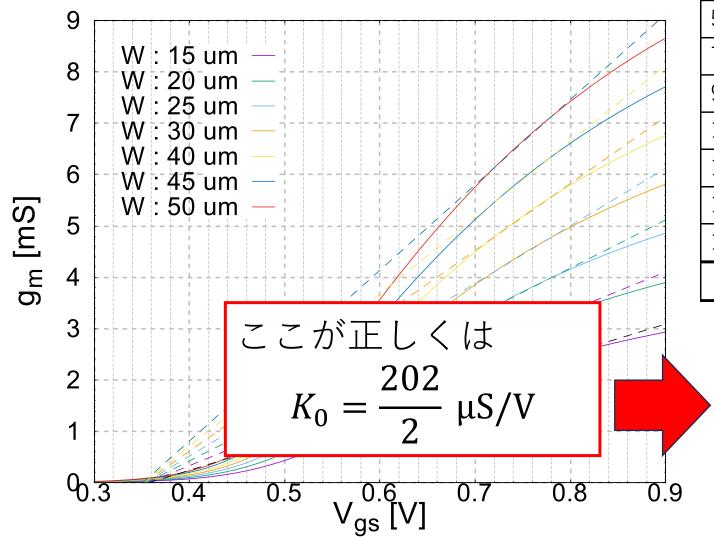
としていた。そのため、 $K_0 \equiv \frac{\mu C_{ox}}{2}$ としていた $K_0 \geq g_m$ が2倍高く出ていた。

Kの再推定(先週の再掲)

process: rohm 0.18 μm



Kの再推定(先週の再掲)



slope	L	W	K
5.6960.E-03	5.400.E-07	1.500.E-05	2.051.E-04
7.5493.E-03	5.400.E-07	2.000.E-05	2.038.E-04
9.3872.E-03	5.400.E-07	2.500.E-05	2.028.E-04
1.1212.E-02	5.400.E-07	3.000.E-05	2.018.E-04
1.3027.E-02	5.400.E-07	3.500.E-05	2.010.E-04
1.4831.E-02	5.400.E-07	4.000.E-05	2.002.E-04
1.6627.E-02	5.400.E-07	4.500.E-05	1.995.E-04
ave.			2.020.E-04

したがって今回は $K \equiv 202 \,\mu\text{S/V}$ とした。

バッファ素子値の再計算

 $g_m = 20 \text{ mS}$ を仮定した際、以下の式が成り立つ。 詳しい計算はスライド最後に記載

$$V_{out}(r_{1}) = \frac{V_{inb} + V_{th0} - \frac{g_{m1}}{K \cdot r_{1}}}{1 + T} \cdots (1)$$

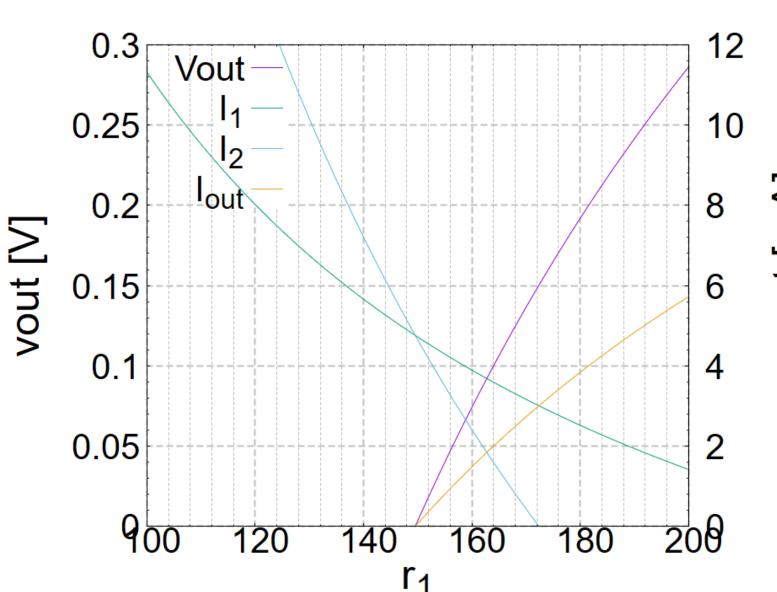
$$I_{out} = \frac{V_{out}(r_{1})}{R_{out}} \cdots (2)$$

$$I_{1}(r_{1}) \equiv \frac{g_{m1}}{2} \{v_{gs}(r_{1}) - V_{th}(r_{1})\} \cdots (3)$$

$$I_{2} \equiv I_{1}(r_{1}) - I_{out}(r_{1}) \cdots (4)$$

$$V_{inb} \downarrow V_{bias1} \downarrow I_{2} \downarrow R_{out}$$

バッファ素子値の再計算



(1)~(4)式をプロットすると左のようになる。

 I_2 が大きくなると V_{out} が小さくなる \Rightarrow 出力 振幅に余裕を持たせる ため $I_1 = I_{out}$ で使用

バッファ素子値の再計算

(2),(3)式より、 M_1 の形状比は

$$r_1 = \frac{(1+T) \cdot g_m}{2K\{V_{inb} + (2+T)V_{th0}\}}$$
 (5)

で求められる。ただし、 $V_{th}(r) = T \cdot V_{out}(r) + V_{th0}$ であり、

今回は $T=0.167781, V_{th0}=0.424192$ Vである。

また、 $V_{inb} = 0.9 \text{ V} とした。$

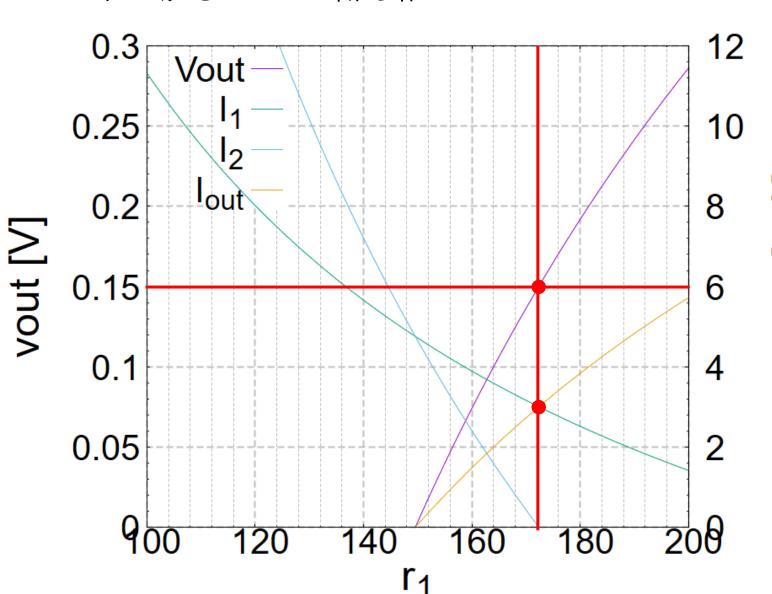
この時 M_1 の形状比 \hat{r} は

$$\hat{r} = 172.372 \dots \approx 172$$

$$L_1 = 0.54 \, \mu m$$
なので、

$$W_1 = \hat{r} \cdot L_1 \approx 93 \; \mu \text{m}$$

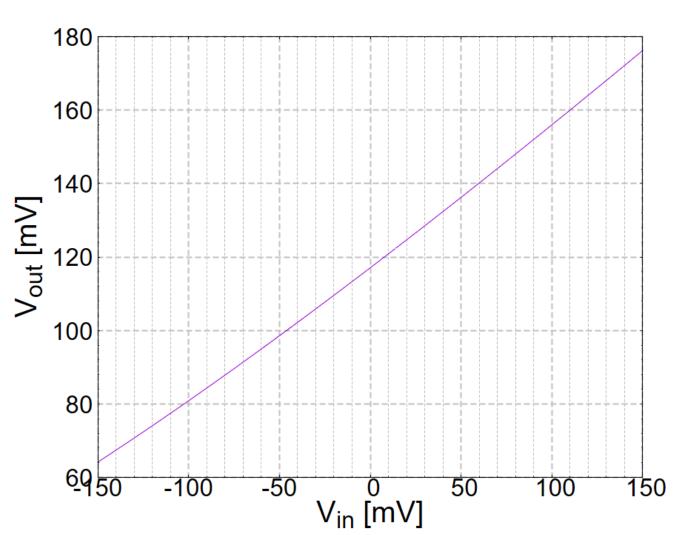
直流の理論値



前回、モデルの関係上チャネル幅を $10.1 \, \mu m \sim 50 \, \mu m$ で設計する前提で K_0 を求めた。そのため、 $W_1=15.5 \, \mu m$ の6並列とした。

計算上、今回の形状比では $V_{out}=0.15\,\mathrm{mV}$ となるはず。

バッファのシミュレーション

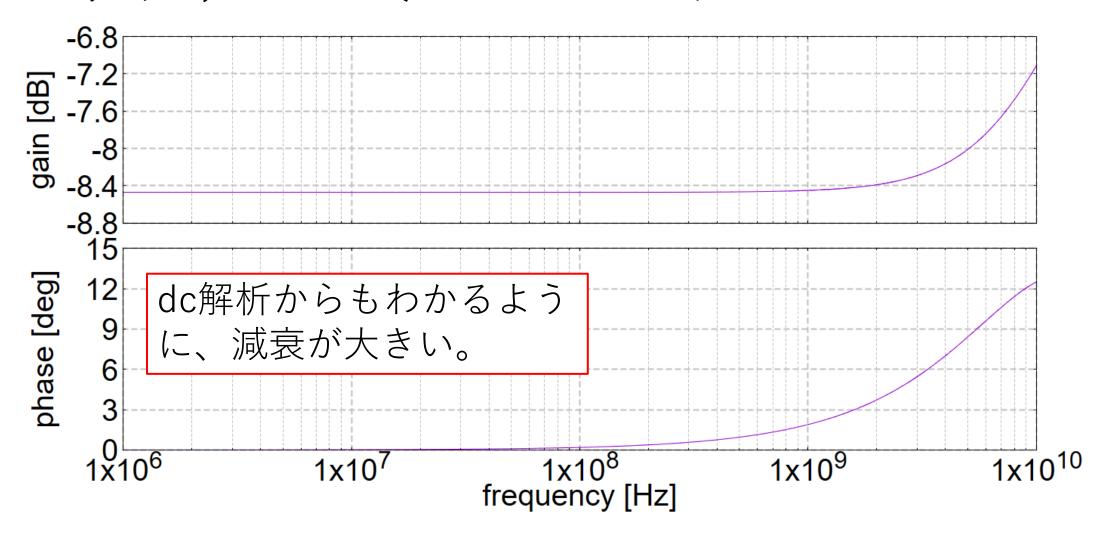


入力が0Vの時、出力はおよそ $115 \, \text{mV}$ であった。

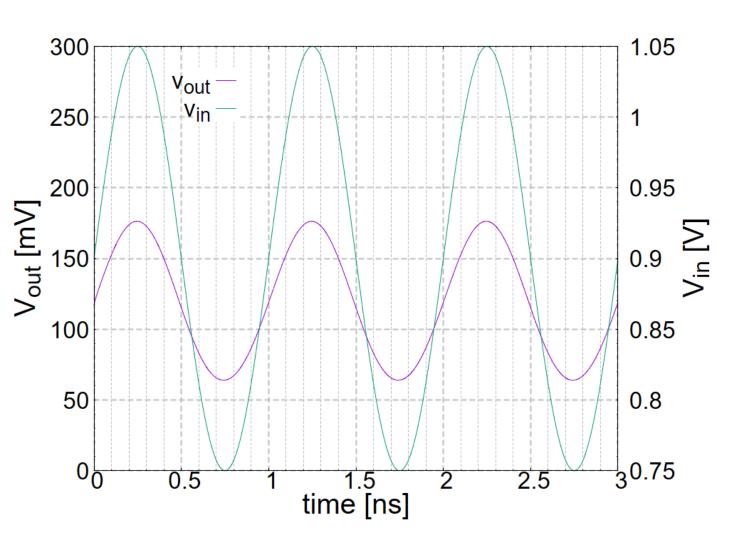
Op解析では $g_m=13.74$ mS、 $g_d=12.37$ μ S、 $V_{th}=499$ mVとなっていた。

求めたしきい電圧の一次式では、 出力が $115 \, \text{mV}$ のときおよそ $440 \, \text{mV}$ だったので、原因は閩電 圧の一次式にあると考えられる。

バッファのシミュレーション



バッファのシミュレーション



左は入力 1 GHz / 150 mVの時 の過渡解析結果である。 出力のオフセットはおよそ 120 mV、振幅は50 mV程度と 減衰している様子が分かる。

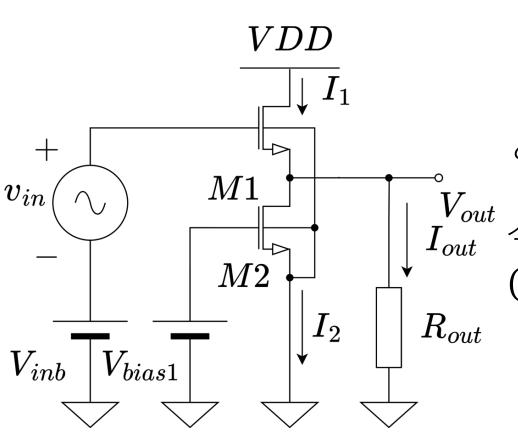
バッファ設計のまとめ

- K_0 の値を修正し、おおよその設計ができた
- チャネル形状によりしきい電圧が変化する
- 今回はこれで設計は終了にする

• 今後設計するときはしきい電圧を再度考証する

素子値計算の詳細 - (1)式の導出

素子値計算の詳細 - (2)式の導出



$$I_1(r_1) \equiv \frac{g_{m1}}{2} \{ v_{gs}(r_1) - V_{th}(r_1) \} \cdots (3)$$
 $I_2 \equiv I_1(r_1) - I_{out}(r_1) \cdots (4)$ と形状比についての関数で表すことができる

 V_{out} 今回は電流源を取り外すので (2)式 = (3)式より R_{out} $\frac{g_{m1}}{2}\{v_{gs}(r_1) - V_{th}(r_1)\} = \frac{V_{out}(r)}{R_{out}}$

素子値計算の詳細 - (2)式の導出

$$\frac{g_{m1}}{2} \left\{ v_{gs}(r_1) - V_{th}(r_1) \right\} = \frac{V_{out}(r)}{R_{out}}$$

$$\left(\because v_{gs}(r_1) = V_{inb} - V_{out}(r_1), V_{th}(r_1) = T \cdot V_{out}(r_1) + V_{th0}, g_{m1} = \frac{1}{R_{out}} \right)$$

$$\frac{g_{m1}}{2} \left[V_{inb} - V_{out}(r_1) - \left\{ T \cdot V_{out}(r_1) + V_{th0} \right\} \right] = g_{m1} V_{out}(r_1)$$

$$(3 + T) V_{out}(r_1) = V_{inb} - V_{th0}$$

$$(3 + T) \cdot \frac{V_{inb} + V_{th0} - \frac{g_{m1}}{K \cdot r_1}}{1 + T} = V_{inb} - V_{th0}$$

$$r_1 = \frac{(3 + T) g_{m1}}{2K_0 \left\{ V_{inb} + (2 + T) V_{th0} \right\}}$$